

SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) L. 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E3 ELETTRONICA PRESSO IL DIPARTIMENTO POLITECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, BANDITA CON D.R. N. 649 DEL 23/09/2019, IL CUI AVVISO È PUBBLICATO NELLA G.U. N. 80 DEL 08/10/2019

La Commissione giudicatrice, terminati i lavori della selezione in oggetto, formula la seguente

RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice, costituita in base al D.R. N. 904 del 22/11/2019, si è riunita in prima seduta il giorno 05/12/2019 alle ore 8:30 in modalità telematica, ed ha designato quale Presidente il Prof. David Esseni e quale Segretario la Prof.ssa Elena Gnani; in tale seduta ha preso atto dei criteri per la selezione dei candidati.

La Commissione giudicatrice si è riunita in seconda seduta il giorno 17/12/2019 alle ore 9:00 in modalità telematica per la valutazione preliminare comparativa; in tale seduta ha proceduto a prendere visione del candidato ammesso, ha formulato un motivato giudizio analitico per il candidato, ha effettuato la valutazione comparativa e ha ammesso alla discussione il candidato Daniel Lizzit.

La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 17/01/2020 alle ore 12 nella Sala Gialla del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine per la discussione dei titoli e della produzione scientifica. La Commissione giudicatrice ha accertato l'identità del candidato, ha condotto un colloquio col candidato ai fini di attribuire un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni, e ha infine designato il vincitore e formulato la graduatoria.

La Commissione, con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti, dichiara vincitore della presente selezione il sottoindicato candidato:

Daniel Lizzit Punteggio: 92

e formula la seguente graduatoria:

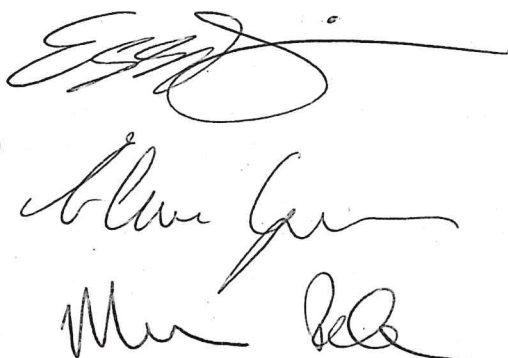
Daniel Lizzit Punteggio 92

Alla presente relazione finale sono annessi tutti gli allegati delle singole fasi della procedura, che ne fanno parte integrante.

Il prof. David Esseni si impegna a consegnare gli atti della presente selezione al Responsabile del Procedimento.

Udine, 17/01/2020

Prof. David Esseni, Presidente
Dr. Marco Pala, Componente
Prof.ssa Elena Gnani, Segretario



VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) L. 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E3 ELETTRONICA PRESSO IL DIPARTIMENTO POLITECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, BANDITA CON D.R. N. 649 DEL 23/09/2019, IL CUI AVVISO È PUBBLICATO NELLA G.U. N. 80 DEL 08/10/2019

ALLEGATO 1) al Verbale 1

CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione giudicatrice della selezione in oggetto prende atto dei criteri di valutazione previsti dal bando.

La selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

La commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo eventualmente indicato nell' art. 1 del bando, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui all'art. 4 del bando sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e col profilo eventualmente indicato nell' art. 1 del bando (*verificare se art. 1 del bando contiene la voce "Profilo"*), ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.



La commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La commissione decide di non utilizzare gli indicatori (c) "impact factor" totale e (d) "impact factor" medio per pubblicazione, in quanto per questi ultimi indicatori non è consolidato un uso comune a livello internazionale nella comunità scientifica di riferimento.

(Qualora il bando preveda, in art. 1, un limite di pubblicazioni che i candidati possono presentare)

La commissione prende atto che il bando prevede che i candidati possano presentare le pubblicazioni nel numero massimo di quattordici.

Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore al limite indicato, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse in numero pari al limite di cui sopra, prendendo in considerazione le più recenti come data di pubblicazione.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in regola con i requisiti di cui all'art. 2, primo comma, del bando, e con gli eventuali requisiti ulteriori indicati nel medesimo articolo, saranno ammessi, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica. Saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

L'esito della valutazione preliminare verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell'Ateneo.

A seguito della discussione la commissione giudicatrice attribuirà un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

Il punteggio massimo attribuibile a titoli e pubblicazioni è pari a 100 ed è così ripartito: *(riportare la ripartizione del punteggio indicata nel bando)*

- titoli 30 punti
- pubblicazioni 70 punti

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, 05 dicembre 2019.

Prof. David Esseni, Presidente
Dr. Marco Pala, Componente
Prof.ssa Elena Gnani, Segretario



ALLEGATO A al Verbale 2
Valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica

- **Candidato:** Lizzit Daniel

Tipologie di titoli	Titoli presentati dal candidato e valutati
Dottorato di ricerca o equipollenti*, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero	Dottorato in Ingegneria Industriale e dell'Informazione conseguito presso l'Università degli Studi di Udine conseguito nel 2016.
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero	/
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri	Dal 15/05/2017 ad oggi è stato assegnista di ricerca <i>post-doc</i> presso Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A, Italy, dove ha svolto attività di ricerca riguardanti la crescita e caratterizzazione di nanostrutture basate su grafene e semiconduttori bidimensionali, per applicazioni legate a dispositivi elettronici e a processi di catalisi. Dal 16/03/2016 al 15/03/2017 ed in precedenza dal 16/05/2012 al 31/12/2012 è stato assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Udine, occupandosi di diversi aspetti di modellistica numerica legata a transistori CMOS avanzati caratterizzati da materiali alternativi al silicio, da uno sfruttamento tecnologico della deformazione meccanica (<i>strain</i>) e dall'uso di architetture di dispositivo di tipo tridimensionale.
Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze	/
Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista	Il candidato ha partecipato alla realizzazione di diverse attività progettuali. Dal 2012 al 2016 è stato coinvolto in un progetto finanziato dalla multinazionale dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), dal 2014 al 2015 ha collaborato al progetto Technology CAD for III-V Semiconductor based MOSFETs (IIIV-MOS) finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del VII programma quadro, e dal 2012 al 2013 ha contribuito al progetto FIRB "Futuro in Ricerca 2010" finanziato dal MIUR.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi	Durante il periodo di Dottorato e i periodi come assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Udine, il candidato è stato incluso nel gruppo di ricerca di nanoelettronica dell'Università degli Studi di Udine, e ha contribuito a progetti di ricerca finanziati dall'industria (ad esempio il progetto finanziato da TSMC dal 2014 al 2015), e da enti di finanziamento pubblici (ad esempio il progetto FIRB "Futuro in Ricerca 2010" finanziato dal MIUR, ed il progetto IIIV-MOS finanziato dalla Comunità Europea nel VII programma quadro).
Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista	/
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	Il candidato risulta relatore di undici interventi a congressi e convegni nazionali e internazionali.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	Il candidato ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: a) Secondo posto per la miglior tesi di Dottorato dell'anno 2016, valutata dalla Associazione Gruppo Italiano di Elettronica; b) Best paper Award 2015 alla 45th European Solid State device research Conference per l'articolo intitolato "Improved surface roughness modeling and mobility projections in thin body MOSFET".
Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista	/

Publicazioni presentate dal candidato e valutate: (riportare gli estremi di ciascuna pubblicazione rispettando il limite previsto dal bando)

- 1) H. Beyer, G. Rohde, A. Grubišić Čabo, A. Stange¹, T. Jacobsen¹, L. Bignardi, D. Lizzit, P. Lacovig, C. E. Sanders, S. Lizzit, K. Rossnagel, P. Hofmann, and M. Bauer, "80% Valley Polarization of Free Carriers in Singly Oriented Single-Layer WS₂ on Au(111)", Phys. Rev. Lett. 123, 236802
- 2) Lizzit Daniel, Trioni Mario, Bignardi Luca, Lacovig Paolo, Lizzit Silvano, Martinazzo Rocco, Larciprete Rosanna, "Dual-route hydrogenation of the graphene/Ni interface²", ACS Nano, vol. 13, n. 2, pp.1828-1838, 2019
- 3) Sanjoy Kr Mahatha, Philip Hofmann, Daniel Lizzit, Silvano Lizzit, Alessandro Baraldi, Arlette S. Ngankeu, Nicki Frank Hinsche, Ingrid Mertig, Kevin Guilloy, Peter L. Matzen, Marco Bianchi, Charlotte E. Sanders, Jill A. Miwa, Harsh Bana, Elisabetta Travaglia, Paolo Lacovig, Luca Bignardi, Rosanna Larciprete, "Electron-phonon coupling in single-layer MoS₂", Surface Science, vol. 681, pp. 64-69, 2019.
- 4) Luca Bignardi, Daniel Lizzit, Harsh Bana, Elisabetta Travaglia, Paolo Lacovig, Charlotte E. Sanders, Maciej Dendzik, Matteo Michiardi, Marco Bianchi, Moritz Ewert, Lars Buß, Jens Falta, Jan Ingo Flege, Alessandro Baraldi, Rosanna Larciprete, Philip Hofmann, Silvano Lizzit, "Growth and Structure of Singly-Oriented Single-Layer Tungsten Disulfide on Au(111)", Phys. Rev. Materials, 3, 014003, 2019.
- 5) Philipp Eickholt, Charlotte Sanders, Maciej Dendzik, Luca Bignardi, Daniel Lizzit, Silvano Lizzit, Albert Bruix, Philip Hofmann and Markus Donath, "Spin structure of K valleys in single-layer WS₂ on Au(111)", Phys. Rev. Lett. 121, 136402, 2018.

6) O. Badami, D. Lizzit, F. Driussi, P. Palestri, L. Selmi and D. Esseni, Benchmarking of 3D MOSFET architectures: Focus on the impact of surface roughness and self-heating, IEEE Trans. On Electron Devices, vol. 65, no. 9, pp. 3646-3653, 2018.
7) Fabian Arnold, Raluca-Maria Stan, Sanjoy K. Mahatha, H. E. Lund, Davide Curcio, Maciej Dendzik, Harsh Bana, Elisabetta Travaglia, Luca Bignardi, Paolo Lacovig, Daniel Lizzit, Zheshen Li, Marco Bianchi, Jill A. Miwa, Martin Bremholm, Silvano Lizzit, Philip Hofmann, C. E. Sanders, "Novel single-layer vanadium sulphide phases", 2D Materials, vol.5, n.4, pp.045009, 2018.
8) Harsh Bana, Elisabetta Travaglia, Luca Bignardi, Paolo Lacovig, Charlotte E. Sanders, Maciej Dendzik, Matteo, Michiardi, Marco Bianchi, Daniel Lizzit, Francesco Presel, Dario De Angelis, Nicoleta Apostol, Pranab Kumar, Das, Jun Fujii, Ivana Vobornik, Rosanna Larciprete, Alessandro Baraldi, Philip Hofmann, Silvano Lizzit, "Epitaxial Growth of Single-Orientation High-Quality MoS ₂ Monolayers", 2D Materials 5(3),035012, 2018.
9) Søren Ulstrup, Paolo Lacovig, Fabrizio Orlando, Daniel Lizzit, Luca Bignardi, Matteo Dalmiglio, Marco Bianchi, Federico Mazzola, Alessandro Baraldi, Rosanna Larciprete, Philip Hofmann, and Silvano Lizzit, "Photoemission Investigation of Oxygen Intercalated Epitaxial Graphene on Ru(0001)", Surface Science, Vol.678, pp. 57-64Dec. 2018.
10) D. Lizzit, O. Badami, R. Specogna and D. Esseni, "Improved surface-roughness scattering and mobility models for multi-gate FETs with arbitrary cross-section", Journal of Applied Physics, vol. 121, pp. 245301, Dec.2017.
11) E.Caruso, P.Palestri, D.Lizzit, P.Osgnach, D.Esseni, L.Selmi, "Quasi-Ballistic Γ - and L-Valleys Transport in Ultrathin Body Strained (111) GaAs nMOSFETs", IEEE Transactions On Electron Devices, IEEE vol. 63, no. 12, 2016
12) O.Badami, E.Caruso, D. Lizzit, P. Osgnach, D. Esseni, P. Palestri, L. Selmi, "An improved surface roughness scattering model for bulk, thin body and quantum-well MOSFETs", IEEE Trans. On Electron Devices, Vol. 63, No. 6, 2016.
13) D. Lizzit, D. Esseni, P.Palestri, P. Osgnach, and L. Selmi, "Performance Benchmarking and Effective Channel Length for Nanoscale InAs, In _{0.53} Ga _{0.47} As, and sSi n-MOSFETs", IEEE Trans. On Electron Devices, Vol. 61, No. 6, pp. 2027-2034, June 2014.
14) D.Lizzit, P.Palestri, D.Esseni, Revelant, and L. Selmi, "Analysis of the performance of n-type FinFETs with strained SiGe channel", IEEE Trans. On Electron.Dev., vol. 60, no. 6, pp. 1884-1890, 2013

Giudizio collegiale:

La commissione esprime il seguente giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica del candidato:

L'attività scientifica del candidato si colloca nel quadro dei moderni materiali e dispositivi per la nanoelettronica e comprende lo sviluppo di modelli teorici e di simulazione numerica per dispositivi CMOS, ed inoltre la caratterizzazione sperimentale fisica ed elettrica di materiali bidimensionali. In particolare il candidato si è occupato di trasporto in transistori MOS con materiali alternativi al silicio e architetture a nanofilo e di caratterizzazione di semiconduttori bidimensionali come MoS₂ e WS₂.

La commissione prende atto che il candidato ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali. In particolare dal 2012 al 2016 è stato impegnato in un progetto finanziato dalla multinazionale dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), dal 2014 al 2015 ha collaborato al progetto Technology CAD for III-V Semiconductor based MOSFETs (IIIV-MOS) finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del VII programma quadro, e dal 2012 al 2013 ha contribuito al progetto FIRB "Futuro in Ricerca 2010" finanziato dal MIUR.

Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a 11 convegni internazionali.

La commissione prende atto che il candidato ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:

- Secondo posto per la miglior tesi di Dottorato dell'anno 2016, valutata dalla Associazione Gruppo Italiano di Elettronica;
- Best paper Award 2015 alla 45th European Solid State device research Conference per l'articolo intitolato "Improved surface roughness modeling and mobility projections in thin body MOSFET".

La produzione scientifica del candidato si presenta ricca ed articolata (17 articoli su rivista internazionale con *peer review* e 13 in conferenze nazionali o internazionali con atti del congresso) e non presenta soluzione di continuità a partire dall'anno 2012. Qualità ed intensità dell'attività scientifica sono confermate dai valori assunti da alcuni indicatori utilizzati nell'ambito della comunità internazionale degli ingegneri elettronici.

In particolare, dal CV presentato dal candidato si deduce che, alla data della presentazione della domanda, le metriche bibliometriche determinate in base alle pubblicazioni presentate per la selezione sono:

- numero totale di citazioni delle pubblicazioni presentate: 82;
- numero medio di citazioni delle pubblicazioni presentate: 5.86;
- indice Hirsch pari a 7.

La commissione osserva che la qualità della produzione scientifica è di ottimo livello.

Tutte le pubblicazioni presentate per la selezione denotano chiari elementi di originalità, innovatività e rigore metodologico e la loro rilevanza è testimoniata dall'autorevolezza e dall'ampia diffusione delle riviste. Infine, le tematiche affrontate sono congruenti col settore scientifico disciplinare del concorso.

L'apporto individuale da parte del candidato è individuato anche dal fatto che il nome del candidato è spesso presente fra i primi nella lista di autori. Inoltre, le pubblicazioni presentate per la selezione chiariscono le

competenze tecniche e scientifiche del candidato, e si osserva che le attività di ricerca sono state spesso svolte nell'ambito di collaborazioni con gruppi di ricerca di rilevanza internazionale.

Data, 17/12/2019

Prof. David Esseni, Presidente
Dr. Marco Pala, Componente
Prof.ssa Elena Gnani, Segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Gnani', is written in a cursive style.

**ALLEGATO A al Verbale 3
Punteggi**

- Candidato: Daniel Lizzit

Titoli	punti	25
Publicazioni (riportare gli estremi di ciascuna pubblicazione valutata)		
1) H. Beyer, G. Rohde, A. Grubišić Čabo, A. Stange ¹ , T. Jacobsen ¹ , L. Bignardi, D. Lizzit, P. Lacovig, C. E. Sanders, S. Lizzit, K. Rossnagel, P. Hofmann, and M. Bauer, "80% Valley Polarization of Free Carriers in Singly Oriented Single-Layer WS ₂ on Au(111)", <i>Phys. Rev. Lett.</i> 123 , 236802	punti	5
2) Lizzit Daniel, Trioni Mario, Bignardi Luca, Lacovig Paolo, Lizzit Silvano, Martinazzo Rocco, Larciprete Rosanna, "Dual-route hydrogenation of the graphene/Ni interface ² ", <i>ACS Nano</i> , vol. 13, n. 2, pp.1828-1838, 2019	punti	5
3) Sanjoy Kr Mahatha, Philip Hofmann, Daniel Lizzit, Silvano Lizzit, Alessandro Baraldi, Arlette S. Nkankeu, Nicki Frank Hinsche, Ingrid Mertig, Kevin Guilloy, Peter L. Matzen, Marco Bianchi, Charlotte E. Sanders, Jill A. Miwa, Harsh Bana, Elisabetta Travaglia, Paolo Lacovig, Luca Bignardi, Rosanna Larciprete, "Electron-phonon coupling in single-layer MoS ₂ ", <i>Surface Science</i> , vol. 681, pp. 64-69, 2019.	punti	4
4) Luca Bignardi, Daniel Lizzit, Harsh Bana, Elisabetta Travaglia, Paolo Lacovig, Charlotte E. Sanders, Maciej Dendzik, Matteo Michiardi, Marco Bianchi, Moritz Ewert, Lars Buß, Jens Falta, Jan Ingo Flege, Alessandro Baraldi, Rosanna Larciprete, Philip Hofmann, Silvano Lizzit, "Growth and Structure of Singly-Oriented Single-Layer Tungsten Disulfide on Au(111)", <i>Phys. Rev. Materials</i> , 3 , 014003, 2019.	punti	5
5) Philipp Eickholt, Charlotte Sanders, Maciej Dendzik, Luca Bignardi, Daniel Lizzit, Silvano Lizzit, Albert Bruix, Philip Hofmann and Markus Donath, "Spin structure of K valleys in single-layer WS ₂ on Au(111)", <i>Phys. Rev. Lett.</i> 121 , 136402, 2018.	punti	5
6) O. Badami, D. Lizzit, F. Driussi, P. Palestri, L. Selmi and D. Esseni, Benchmarking of 3D MOSFET architectures: Focus on the impact of surface roughness and self-heating, <i>IEEE Trans. On Electron Devices</i> , vol. 65, no. 9, pp.3646-3653, 2018.	punti	5
7) Fabian Arnold, Raluca-Maria Stan, Sanjoy K. Mahatha, H. E. Lund, Davide Curcio, Maciej Dendzik, Harsh Bana, Elisabetta Travaglia, Luca Bignardi, Paolo Lacovig, Daniel Lizzit, Zheshen Li, Marco Bianchi, Jill A. Miwa, Martin Bremholm, Silvano Lizzit, Philip Hofmann, C. E. Sanders, "Novel single-layer vanadium sulphide phases", <i>2D Materials</i> , vol.5, n.4, pp.045009, 2018.	punti	5
8) Harsh Bana, Elisabetta Travaglia, Luca Bignardi, Paolo Lacovig, Charlotte E. Sanders, Maciej Dendzik, Matteo, Michiardi, Marco Bianchi, Daniel Lizzit, Francesco Presel, Dario De Angelis, Nicoleta Apostol, Pranab Kumar, Das, Jun Fujii, Ivana Vobornik, Rosanna Larciprete, Alessandro Baraldi, Philip Hofmann, Silvano Lizzit, "Epitaxial Growth of Single-Orientation High-Quality MoS ₂ Monolayers", <i>2D Materials</i> 5 (3),035012, 2018.	punti	4
9) Søren Ulstrup, Paolo Lacovig, Fabrizio Orlando, Daniel Lizzit, Luca Bignardi, Matteo Dalmiglio, Marco Bianchi, Federico Mazzola, Alessandro Baraldi, Rosanna Larciprete, Philip Hofmann, and Silvano Lizzit, "Photoemission Investigation of Oxygen Intercalated Epitaxial Graphene on Ru(0001)", <i>Surface Science</i> , Vol.678, pp. 57-64Dec. 2018.	punti	4
10) D. Lizzit, O. Badami, R. Specogna and D. Esseni, "Improved surface-roughness scattering and mobility models for multi-gate FETs with arbitrary cross-section", <i>Journal of Applied Physics</i> , vol. 121, pp. 245301, Dec.2017.	punti	5
11) E.Caruso, P.Palestri, D.Lizzit, P.Osgnach, D.Esseni, L.Selmi, "Quasi-Ballistic Γ - and L-Valleys Transport in Ultrathin Body Strained (111) GaAs nMOSFETs", <i>IEEE Transactions On Electron Devices</i> , IEEE vol. 63, no. 12, 2016	punti	5
12) O.Badami, E.Caruso, D. Lizzit, P. Osgnach, D. Esseni, P. Palestri, L. Selmi, "An improved surface roughness scattering model for bulk, thin body and quantum-well MOSFETs", <i>IEEE Trans. On Electron Devices</i> , Vol. 63, No. 6, 2016.	punti	5
13) D. Lizzit, D. Esseni, P.Palestri, P. Osgnach, and L. Selmi, "Performance Benchmarking and Effective Channel Length for Nanoscale InAs, In _{0.53} Ga _{0.47} As, and sSi n-MOSFETs", <i>IEEE Trans. On Electron Devices</i> , Vol. 61, No. 6, pp. 2027-2034, June 2014.	punti	5
14) D.Lizzit, P.Palestri, D.Esseni, Revelant, and L. Selmi, "Analysis of the performance of n-type FinFETs with strained SiGe channel", <i>IEEE Trans. On Electron.Dev.</i> , vol. 60, no. 6, pp. 1884-1890, 2013	punti	5
Totale pubblicazioni	punti	67
TOTALE	PUNTI	92

Udine, 17/01/2020

Prof. David Esseni, Presidente
Dr. Marco Pala, Componente
Prof.ssa Elena Gnani, Segretario

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is David Esseni's, the middle one is Marco Pala's, and the bottom one is Elena Gnani's.